

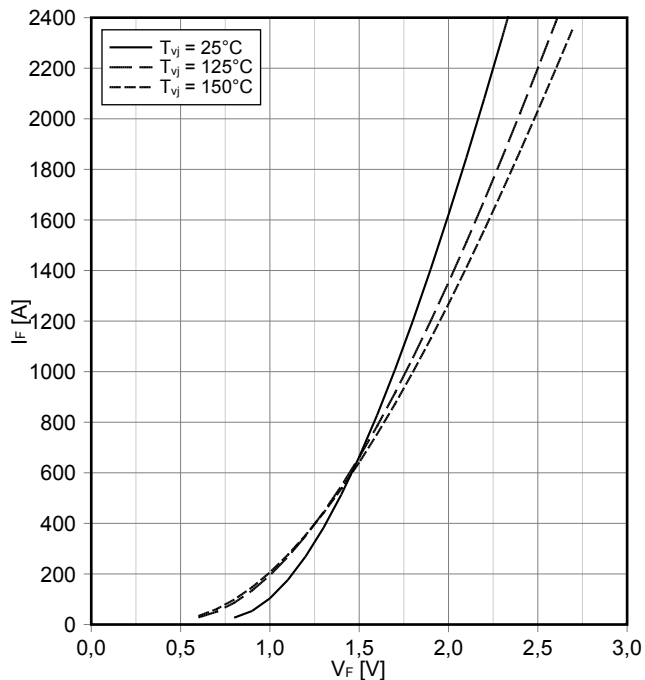
モジュール / Module

絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	4,0		kV
ベースプレート材質 Material of module baseplate			AISiC		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		32,2 32,2		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		19,1 19,1		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI	> 400		
			min.	typ.	max.
内部インダクタンス Stray inductance module		L _{sCE}		18	nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	T _c = 25°C, /スイッチ / per switch	R _{AA'+CC'}		0,24	mΩ
保存温度 Storage temperature		T _{stg}	-40		150 °C
取り付けネジ締め付けトルク Mounting torque for modul mounting	取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	4,25		5,75 Nm
主端子ネジ締め付けトルク Terminal connection torque	取り付けネジ M4 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M4 - Mounting according to valid application note	M	1,8	-	2,1 Nm
	取り付けネジ M8 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M8 - Mounting according to valid application note		8,0	-	10 Nm
質量 Weight		G		800	g

Dynamische Daten gehen in Verbindung mit FD1200R17HP4-K_B2 Modul
Dynamic data valid in conjunction with FD1200R17HP4-K_B2 module

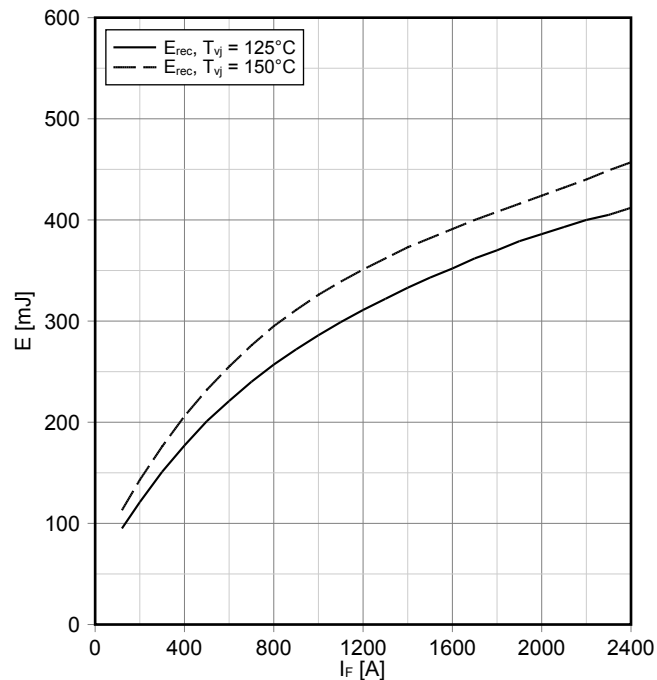
prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1

順電圧特性 Diode、インバータ (typical)
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
 $I_F = f(V_F)$



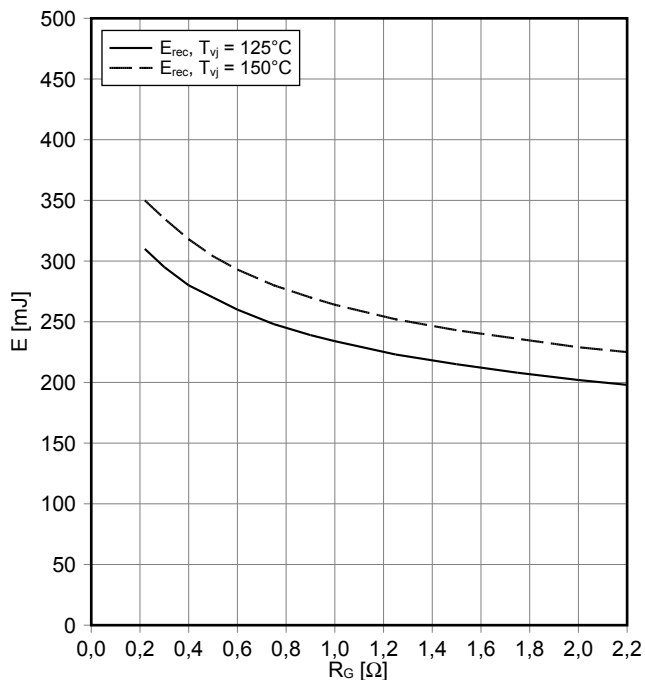
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)
switching losses Diode, Inverter (typical)
 $E_{rec} = f(I_F)$

$R_{Gon} = \Omega, V_{CE} = 900\text{ V}$



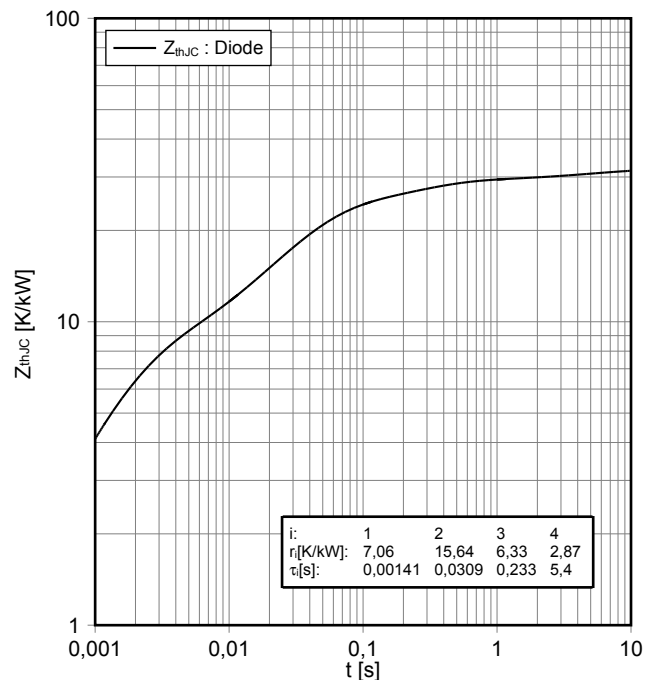
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)
switching losses Diode, Inverter (typical)
 $E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 1200\text{ A}, V_{CE} = 900\text{ V}$



過渡熱インピーダンス Diode、インバータ
transient thermal impedance Diode, Inverter
 $Z_{thJC} = f(t)$

$Z_{thJC} = f(t)$



prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1